The second second section 2500



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 60065712 A

(43) Date of publication of application: 15 . 04 . 85

(51) Int. CI

C01B 33/113 // B01J 19/12

(21) Application number: 68172222

(71) Applicant: TOSHIBA CORP

(22) Date of filing: 20 . 09 . 83

(72) inventor:

HAYAMA NORIYUKI YUGE YOU WATANABE TSUTOMU ISHIZAKI ARIYOSHI

(54) FORMATION OF SILICON OXIDE COATING FILM

(57) Abstract:

PURPOSE: A substrate is coated with an organosilicon compound containing ultra- violet absorbing substances and sintered in an oxidative atmosphere as ultraviolet rays are irradiated to effect oxidation whereby good costing films of silicon code are formed at relatively low temperatures.

CONSTITUTION: A substrate is coated with an

organosilicon compound containing an ultraviolet absorbing substance such as an organotitanium compound and placed in a heating furnace, then baked in an oxidative atmosphere at about 350°C, as ultraviolet rays are irradicted to oxidize the organositicon compound and form coating films of silicon code on the substrate. Thus, silicon oxide coating films used as optical interference films with high retractive index.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出顧公開

母公開特許公報(A)

昭60-65712

@Int_CI_4
C 01 B 33/113
B 01 J 19/12

į

1

做別記号

广内整理番号

砂公開 昭和60年(1985)4月15日

7059-4G 6542-4G

審査請求 未請求 発明の散 1 (全 3 頁)

❷発明の名称 酸化けい素被膜の形成方法

砂特 顧 昭58-172222

登出 顧 昭58(1983)9月20日

砂発 明 者 ш 横須賀市船越町1の201の1 東京芝浦電気株式会社横須 賀工場内 伊発 明者 弓 横須賀市船越町1の201の1 東京芝浦電気株式会社横須 賀工場内 分発 溏 辺 カ 横須賀市船越町1の201の1 東京芝浦電気株式会社横須 賀工場内 0 42 明 石 横須賀市船越町1の201の1 東京芝浦電気株式会社横須 贺工場内

①出 顕 人 株 式 会 社 東 芝 ②代 瑾 人 弁理士 井上 一男

川崎市幸区堀川町72番地

1. 强明の名称

厳化けい 素被膜の形成方法

2、作許健康の規則

3. 発明の詳細を説明

〔発明の技術分野〕

本発明は酸化けい素被膜の形成方法の改良に質する。

〔発明の技能的背景とその問題点〕

職化けい常存度は安定で低風折率でしかも展界 を任念化形成できるととにより、元学存度として 古くから利用されている。また、近年に乗り、彼 島セル用ガラス板のナトリウム市出防止駅とて多用されるようになった。このような硫化けい気被 鉄の形成方法として、従来、真空薫着法、スペッ メ 法、化学的気相析出法などが知られているが、 これらの方法はいずれも製造後低が複様で作素性 にも離点があった。

との方法は袋屋が歯倒で、作業性が良く、大適 数の基体や複雑な形状の基体だも形成が容易であ る。しかし、その反面、強固で安定な威を得るためには、 7 0 0 で以上の高麗で焼成することが必要で、エネルギ的に問題があつた。

(発明の目的)

í

1

į

本現界は比較的低級で発成できる酸化けい 素被 類の形成方法を提供することを目的とする。

(発明の紙長)

有限けいま化合物に無外接吸収物質を総加して 基体に集布し、酸化性界間気中において前外線を 脈射したがら銃成することにより、有限けい素化 合物に良く紫外線を摂収させ、その元化学作用に よつて比較的低温で有機けい素化合物を硬化して 良好な硬化けい素被膜を形成するものである。 〔発明の実施例〕

「鬼男の実施例」

要化けい素薄膜と酸化チョン海線とを4 帰づつ 交互重層してなる光干浄質の形成を例にして数明 する。

810。換算で10重量がのけいまを含む有機けい 果化合物溶液に、Ti: 81 (原子比)=3.5:100 の有機テメン化合物たとえばアルコキンドを前加 特間略60-65712(2)

し、前一に混合した。この混合故に仮状ガラス益 体を表徴し、180年/分の速度で引上げて独布 した。ついて、100V定格高圧水鉄ランプ(本 を装備した常外線炉に入れて空気が配気で焼成を 行をつた。との伊は紫外藤強度 300mW/四、森 定350℃が得られるものである。この疑妖によ つて基体に放布した有後けい素化合物は単数では 2537mm以上の中放長および長放長の気外離を抵 とんど吸収しないにもかかわらず、有級テメン化 合物の共存によつて常外憩を良く吸収するように なり、その光化学作用によつて有機けい気化合物 および有機チョン化合物の両者とも350℃とい り比較的低温であるにもかかわらず、完全にほ化 されて小量の酸化チメンが臨入した酸化けい流か らなる群膜に形成された。ちをみに、この位化け い未存践の該原は1300%で、風折率は1.50で

つぎに、との酸化けい素溶膜を形成した基体を TIO₁ 換算で 6 重角 5 の有額テタン化合物なとえば アルコキンドの液に圧潰し、2 2 0 mm/分の基度

で引上げ、上述の酸化けい素率膜形成のときと同様な条件で美成し、酸化チタン降酸化形成した。 ちなみに、この酸化チタン溶膜の狭厚は $1500 \, 0 \, \lambda$ で、風折率は 2.1.5 であつた。

そうして、以上の操作をそれぞれ4回交互に繰返すことにより8層が重層してなる光干部数が形成された。

この九干部既は基体全面にわたり、所留の光学 特性を有し、ぞの特性分布も均一であつた。ちな みに、その光学特性を配に示す。助は検動に放長 を Mm の単位でとり、餐軸に光透過率かよび光反射 率をいずれるがの単位でとつたもので曲線(3)(実 報で示す。)は透過率、曲額(3)(破骸で示す。) は反射率をそれぞれ示す。

をお、前述の実施例に対し、比較のため、有扱けいま化合物に有機テタン化合物を暴加することを(用い、前述と同様にして光干掛膜を形成したところ、4~5層目で膜全体に剥離が生じた。この理由は取化けい素群腐形成に緊し、有後けいま化合物の一部が充分に東化分解しないまま幾個し、

しかして、常外級級収性物質の採加性は多いほど有機けい常化合物の酸化分解が良くなるが、たとえばテタンの場合には得られた酸化けい素が膜の原折率を上昇させるので、光干参談として用いる場合には2000から抵加量が制限される。他の常外酸吸収性物質にも抵加量を銀定する場合がある。

また、紫外藤仮収性物質として有級メンタル化

会物を使用できる。との場合、彼化タンタルは壁化チタンと比較して紫外線の吸収等が若干型放及倒へシフトしているが、それでも300m以外外線に吸収等があるので適当を被長級の紫外線を用いればよい。また、酸化タンタルの別析率の酸化チタンのそれより低く、酸化件にもよるが、可能化力の場合である。また、物収条件にもよるが、可能化力の機能を受けるようの場合を関析率が1.50で10:100の場合属析率が1.53であった。また、既の機能性も良好であった。

また、被品セル用ガラス板のナトリウム溶出防止用酸化けい常被膜の形成の場合も前述と同様にして異態できる。そうして、酸化けい常被膜の膜 単は従来技術と同様にして任意に形成できる。

また、本発明にかいて性成素因気は空気に取らず、空気または窒素をどに酸素。オゾンをどを適 室前加して酸化飽を開整した気体でもよい。さら に、有扱けい素化合物の動布方法は任意である。 特際報60-65712(3)

さらに、基体の材質、単次、大小あるいはその 用途については制限はない。

(発明の効果)

本発明の酸化被膜の形成方法は紫外部改収性物質を軽加した有機けい紫化合物を基体に成むし、酸化性多因気中にかいて紫外線限射しながら焼成して有機けい紫化合物を酸化し硫化けい紫からたる破膜に形成したので、紫外線の光化学作用によって比較的低温でも度好に有機けい紫化合物を放化分解することができ、健成エネルギ節約に役立っ

4. 慰面の簡単を説明

図は本発明の敗化けい米被説の形成方法の一実 施例を適用して得られた光干部説の一例の光学特 性を示すグラフである。

代聯人 弁理士 井 上 一 男

